

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертационной работе Максимова Максима Юрьевича на тему «Управление составом и свойствами никельсодержащих оксидных систем для твердотельных тонкопленочных аккумуляторов с использованием метода молекулярного наслаивания», представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности 1.4.15. Химия твердого тела

Фамилия, имя, отчество	Гудовских Александр Сергеевич
Гражданство	РФ
Ученая Степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Ученое звание (по кафедре, специальности)	нет
Место работы:	
Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	194021, Россия, Санкт-Петербург, улица Хлопина, дом 8, корпус 3, литер А https://spbau.ru/ , office@spbau.ru
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова Российской академии наук»
Наименование подразделения	Лаборатория возобновляемых источников энергии
Должность	Ведущий научный сотрудник
Публикации по специальности 1.4.15. Химия твердого тела:	
1. Gudovskikh A.S., Uvarov Alexander.V., Morozov I.A., Bukatin A.S., Baranov A.I., Kudryashov D.A., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Zubkov V.I., Yakovlev G.E., Kleider J.-P. Study of GaP Nucleation Layers Grown on Si by Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition // physica status solidi (a). – 2020. – Vol. 217, No. 4. – Art. 1900532. 2. Kondratev V.M., Morozov I.A., Vyacheslavova E.A., Kirilenko D.A., Kuznetsov A., Kadinskaya S.A., Nalimova S.S., Moshnikov V.A., Gudovskikh A.S., Bolshakov A.D. Silicon Nanowire-Based Room-Temperature Multi-environment Ammonia Detection // ACS Applied Nano Materials. – 2022. – Vol. 5, № 7. – P. 9940–9949. 3. Uvarov A., Gudovskikh A., Baranov A., Maksimova A., Vyacheslavova E., Kirilenko D. Conformal growth of GaP on high aspect ratio Si structured surface via plasma-enhanced atomic layer deposition // Surface and Coatings Technology. – 2024. – Vol. 477. – Art. 130357. 4. Uvarov A.V., Gudovskikh A.S., Nevedomskiy V.N., Baranov A.I., Kudryashov D.A., Morozov I.A., Kleider J.-P. Low temperature epitaxial growth of GaP on Si by atomic-layer deposition with plasma activation // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2020. – Vol. 53, No. 34. – Art. 345105. 5. Vasilkova E.I., Pirogov E.V., Sobolev M.S., Baranov A.I., Gudovskikh A.S., Khabibullin R.A., Bouravleuv A.D. Carrier density distribution in AlGaAs/GaAs superlattices with different numbers of quantum wells determined by capacitance-voltage profiling// Physica Scripta. – 2024. – Vol. 99, No. 2. – Art. 025951.	

Официальный оппонент

Дата 09.04.2024

Гудовских Александр Сергеевич



Подпись

ПОДПИСЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

